Ordering number:EN2841

N-Channel Junction Silicon FET

2SK932

High-Frequency Low-Noise Amplifier Applications

Applications

· AM tuner RF amplifier, low-noise amplifier.

Features

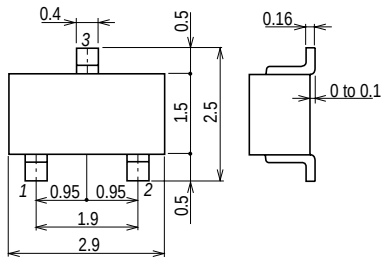
· Adoption of FBET process.
· Large $|y_{fs}|$.
· Small Ciss.
· Ultralow noise figure.
· Ultrasmall-sized package permitting 2SK932-applied sets to be made smaller and slimmer.

Package Dimensions

unit:mm

2050A

[2SK932]



1 : Source
2 : Drain
3 : Gate
SANYO : CP

Specifications

Absolute Maximum Ratings at Ta = 25˚C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
Drain-to-Source Voltage	V_{DSX}		15	V
Gate-to-Drain Voltage	V_{GDS}		–15	V
Gate Current	I_G		10	mA
Drain Current	I_D		50	mA
Allowable Power Dissipation	P_D		200	mW
Junction Temperature	Tj		150	˚C
Storage Temperature	Tstg		–55 to +150	˚C

Electrical Characteristics at Ta = 25˚C

Parameter	Symbol	Conditions	Ratings			Unit
			min	typ	max	
Gate-to-Drain Breakdown Voltage	$V_{(BR)GDS}$	I_G=–10μA, V_{DS}=0V	–15			V
Gate-to-Source Leakage Current	I_{GSS}	V_{GS}=–10V, V_{DS}=0V			–1.0	nA
Zero-Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=5V, V_{GS}=0V	5.0*		24.0*	mA
Cutoff Voltage	$V_{GS(off)}$	V_{DS}=5V, I_D=100μA	–0.2	–0.6	–1.4	V
Forward Transfer Admittance	| yfs |	V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1kHz	25	50		mS

* : The 2SK932 is classified by I_{DSS} as follows (unit : mA) :

5.0	21	8.5	7.3	22	12.0	10.0	23	17.0	14.5	24	24.0

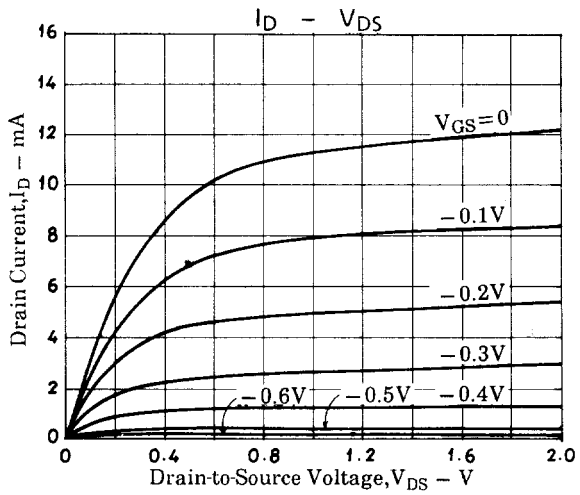
Continued on next page.

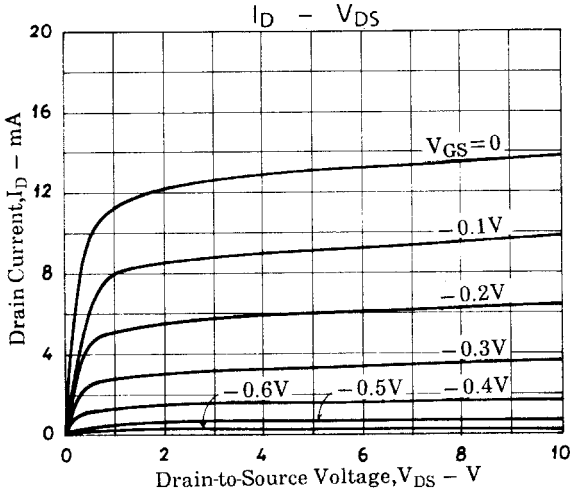
(Note) Marking : E
I_{DSS} rank : 21, 22, 23, 24

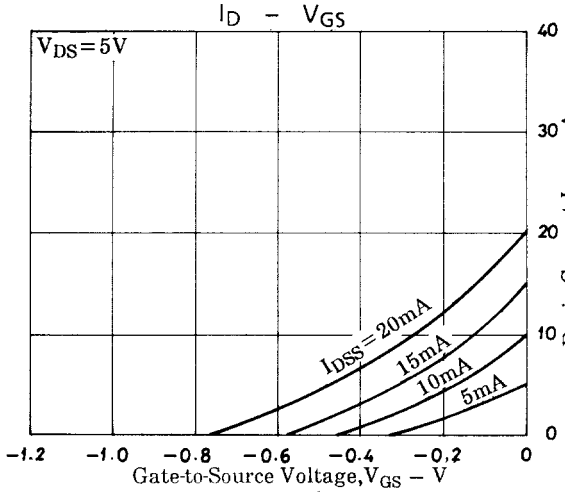
SANYO Electric Co.,Ltd. Semiconductor Company
TOKYO OFFICE Tokyo Bldg., 1-10, 1 Chome, Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110-8534 JAPAN

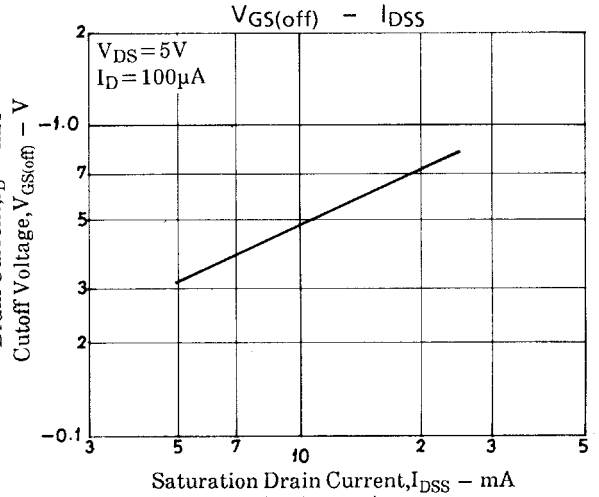
Continued from preceding page.

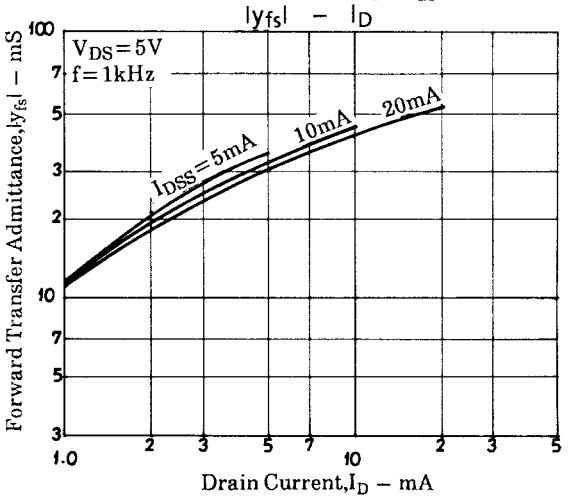
Parameter	Symbol	Conditions	Ratings			Unit
Input Capacitance	Ciss	V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1MHz		10		pF
Reverse Transfer Capacitance	Crss	V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1MHz		3.0		pF
Noise Figure	NF	V_{DS}=5V, Rg=1kΩ, I_D=1mA, f=1kHz		1.5		dB

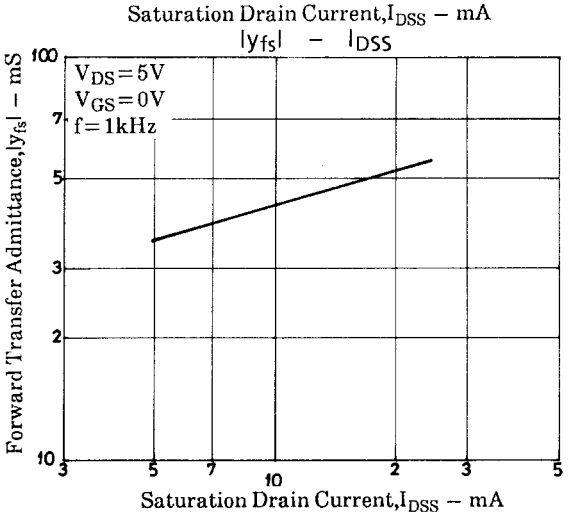


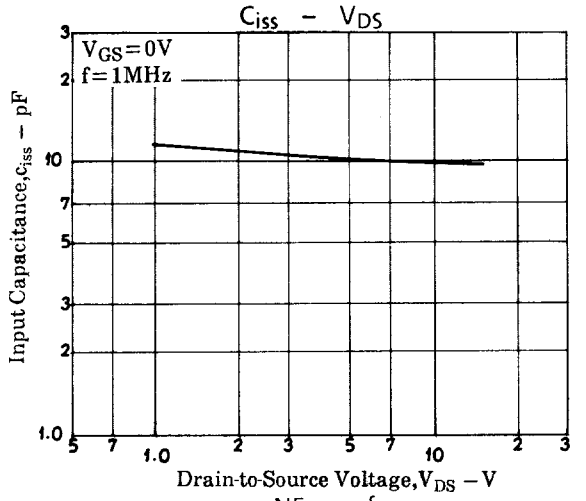


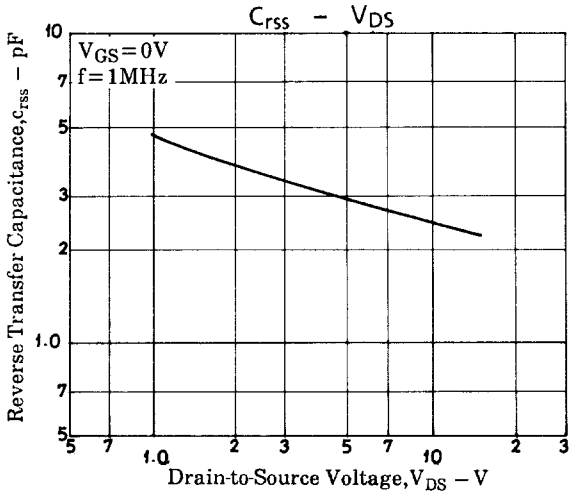


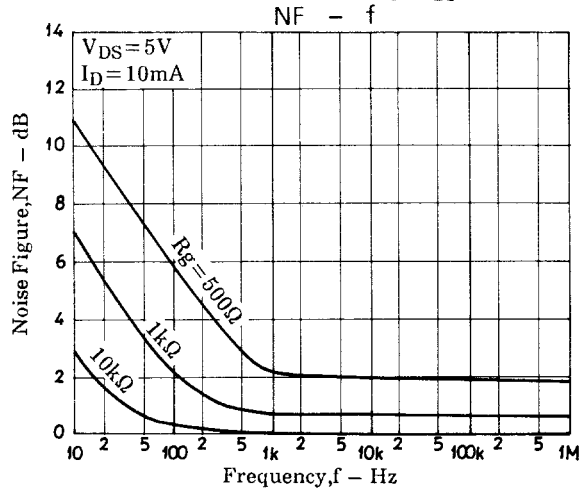


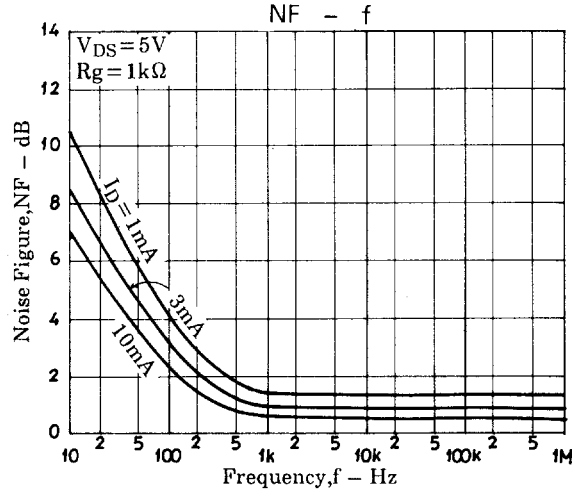


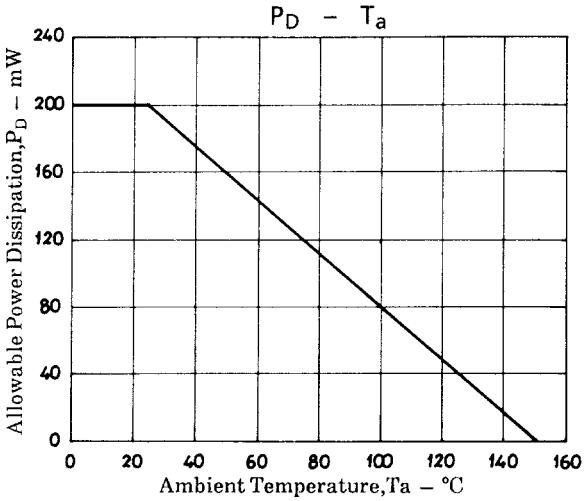



Ciss – VDS
VGS=0V
f=1MHz
Input Capacitance,Ciss – pF
Drain-to-Source Voltage,VDS – V


Crss – VDS
VGS=0V
f=1MHz
Reverse Transfer Capacitance,Crss – pF
Drain-to-Source Voltage,VDS – V


NF – f
VDS=5V
ID=10mA
Rg=500Ω
1kΩ
10kΩ
Noise Figure,NF – dB
Frequency,f – Hz


NF – f
VDS=5V
Rg=1kΩ
ID=1mA
3mA
10mA
Noise Figure,NF – dB
Frequency,f – Hz


PD – Ta
Allowable Power Dissipation,PD – mW
Ambient Temperature,Ta – °C

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9